

## グローバル COE 共催事業

### 「2008 International Meeting for Future of Electron Devices, Kansai」

#### セミナーレポート

主催：Institute of Electrical and Electronics Engineers, Electron Devices Society, Kansai Chapter

日時：2008年5月22日～5月23日

場所：大阪大学中之島センター

事業内容：

2003年以降 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Electron Devices Society (EDS), Kansai Chapter の主催で毎年開催している関西発の電子デバイスの国際会議である。国内外から集めた最先端の論文発表（招待講演含む）に加え、チュートリアル講演も実施した。本 COE プログラムの対象である電子デバイスを広範囲に扱う関西の国際会議であり、共催の意義は大いにあったものと思われる。詳細は、<http://www.imfedk.org/> を参照。

組織委員長：濱川 圭弘（大阪大学名誉教授）

実行委員長：谷口 研二（大阪大学）

#### 【基調講演】

大橋弘通（産総研） "Future Power Electronics for Sustainable Society"

松井俊浩（産総研） "Realtime Processing for Robot Control"

門 勇一（NTT）

"Exploring Sub-THz Waves for Communications, Imaging, and Spectroscopy"

#### 【一般セッションでの招待講演者リスト】

宮本 明（東北大学）

"Multi-Level Combinatorial Computational Chemistry for Future Electron Devices"

小野 行徳（NTT 物性科学基礎研究所）

"Single Boron Detection in Nano-Scale SOI MOSFETs"

浦岡 行治（奈良先端科学技術大学院大学）

"New Functional Devices Fabricated Using Bio-Nano Process"

上田 哲三（松下電器）

"GaN Power Transistor with Ultra High Breakdown Voltage over 10000V"

**【Special Session for Students】**

学生による電子デバイス関連技術のポスター発表 30 件以上

**【チュートリアル講演】**（日本語） 5/22(木) 9:30-11:50

「パワーエレクトロニクス用デバイス・材料」

奥村 元 （産総研） "ワイドギャップ半導体 -パワーエレクトロニクス用材料-"

四戸 孝 （東芝） "パワーエレクトロニクス用デバイスの開発動向"

以上